

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ МНСТ

- Васильев В. Ю.** Технологии получения тонких пленок нитрида кремния для микроэлектроники и микросистемной техники. Часть 7. Обобщение информации по методам осаждения и особенностям пленок 131

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Новиков С. Г., Кадочкин А. С., Беринцев А. В., Светухин В. В., Алексеев А. С.** Моделирование радиолюминесцентных композиций на основе микрочастиц ^{63}Ni для радиоизотопных источников электрического питания 143

- Масальский Н. В.** Расширенный подход к моделированию вольт-амперных характеристик КНИ МОП-транзистора 153

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Карушкин Н. Ф., Обухов И. А., Смирнова Е. А.** Полупроводниковые компоненты и устройства электронной техники в коротковолновой части СВЧ диапазона. Часть I 165

- Камалджит Сингх, Нирмал А. В.** Корпусирование МЭМС-структур для работы в высокочастотной области 178

- Торгашин С. И., Пауткин В. Е.** Особенности применения схем компенсации углового растравливания при формировании МЭМС-структур 186

Аннотации и статьи на русском и английском языках доступны на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) в разделе "Архив статей с 1999 г."

ПОДПИСКА:

по каталогу "Пресса России" (индекс 27849)

в редакции журнала (тел./факс: (499) 269-55-10)

Адрес для переписки:

107076 Москва,

Стромынский пер., д. 4

e-mail: nmst@novtex.ru

Учредитель:

Издательство "Новые технологии"